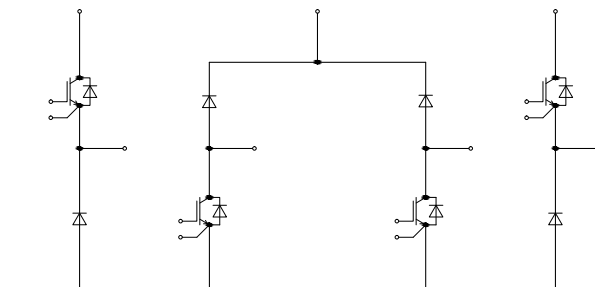
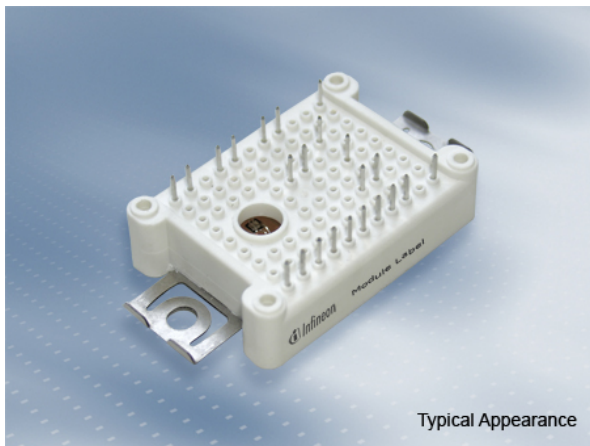


EasyPACK モジュール and PressFIT / NTCサーミスタ
 EasyPACK module and PressFIT / NTC

暫定データ / Preliminary Data



$V_{CES} = 1200V$
 $I_{C\ nom} = 40A / I_{CRM} = 80A$

一般応用

- 高周波スイッチングアプリケーション
- ソーラーアプリケーション

電気的特性

- 650Vに増加したブロッキング電圧
- 高速IGBT H3
- 低インダクタンスデザイン
- 低 V_{CEsat} 飽和電圧

機械的特性

- 2.5 kV AC 1分 絶縁耐圧
- PressFIT 接合 技術
- RoHS対応
- 固定用クランプによる強固なマウンティング

Typical Applications

- High Frequency Switching Application
- Solar Applications

Electrical Features

- Increased blocking voltage capability to 650V
- High Speed IGBT H3
- Low Inductive Design
- Low V_{CEsat}

Mechanical Features

- 2.5 kV AC 1min Insulation
- PressFIT Contact Technology
- RoHS compliant
- Rugged mounting due to integrated mounting clamps

Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



Content of the Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

prepared by: CM	date of publication: 2014-07-21	
approved by: MB	revision: 2.0	UL approved (E83335)



暫定データ
Preliminary Data

IGBT, 降圧コンバータ / IGBT, Buck
最大定格 / Maximum Rated Values

コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1200	V
連続DCコレクタ電流 Continuous DC collector current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	$I_{C\text{nom}}$	40	A
繰り返しピークコレクタ電流 Repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$	I_{CRM}	80	A
トータル損失 Total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	215	W
ゲート・エミッタ間ピーク電圧 Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 40\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 40\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 40\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{sat}}$	2,05 2,50 2,60	2,40	V V V
ゲート・エミッタ間しきい値電圧 Gate threshold voltage	$I_C = 1,00\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		V_{GEth}	5,0 5,8	6,5	V
ゲート電荷量 Gate charge	$V_{GE} = -15\text{ V} \dots +15\text{ V}$		Q_G	0,185		μC
内蔵ゲート抵抗 Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		R_{Gint}	0,0		Ω
入力容量 Input capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{ies}	2,35		nF
帰還容量 Reverse transfer capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{res}	0,13		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流 Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{CES}		1,0	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流 Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{GES}		100	nA
ターンオン遅れ時間 (誘導負荷) Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 40\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 12\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{don}	0,02 0,02 0,023		μs μs μs
ターンオン上昇時間 (誘導負荷) Rise time, inductive load	$I_C = 40\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 12\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_r	0,02 0,02 0,02		μs μs μs
ターンオフ遅れ時間 (誘導負荷) Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 40\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 12\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{doff}	0,22 0,26 0,28		μs μs μs
ターンオフ下降時間 (誘導負荷) Fall time, inductive load	$I_C = 40\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 12\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_f	0,025 0,035 0,04		μs μs μs
ターンオンスイッチング損失 Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 40\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L_S = 25\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, di/dt = 1900\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{Gon} = 12\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{on}	2,50 3,70 4,00		mJ mJ mJ
ターンオフスイッチング損失 Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 40\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L_S = 25\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, du/dt = 4700\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{Goff} = 12\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{off}	1,50 2,35 2,50		mJ mJ mJ
短絡電流 SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 800\text{ V}$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$ $t_P \leq 10\ \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		I_{SC}	130		A
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	IGBT部 (1素子当り) / per IGBT		R_{thJC}	0,55	0,70	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	IGBT部 (1素子当り) / per IGBT $\lambda_{\text{Paste}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		R_{thCH}	0,55		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{op}}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$

prepared by: CM	date of publication: 2014-07-21
approved by: MB	revision: 2.0



暫定データ
Preliminary Data

Diode、リバーズ / Diode, Reverse
最大定格 / Maximum Rated Values

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
連続DC電流 Continuous DC forward current		I_F	10	A
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	$t_P = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	20	A
電流二乗時間積 I^2t - value	$V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I^2t	16,0 14,0	A ² s A ² s

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	$I_F = 10\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 10\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 10\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	V_F	1,75 1,75 1,75	2,25	V V V
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	/Diode (1 素子当り) / per diode		R_{thJC}	1,75	1,90	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/Diode (1 素子当り) / per diode $\lambda_{Paste} = 1\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ / $\lambda_{grease} = 1\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		R_{thCH}	1,30		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj\ op}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$

Diode, 降圧コンバータ / Diode, Buck
最大定格 / Maximum Rated Values

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
連続DC電流 Continuous DC forward current		I_F	15	A
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	$t_P = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	30	A
電流二乗時間積 I^2t - value	$V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I^2t	90,0 75,0	A ² s A ² s

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	$I_F = 15\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 15\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 15\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	V_F	2,00 1,70 1,65	2,55	V V V
ピーク逆回復電流 Peak reverse recovery current	$I_F = 15\text{ A}, -di_F/dt = 1500\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I_{RM}	30,0 40,0 40,0		A A A
逆回復電荷量 Recovered charge	$I_F = 15\text{ A}, -di_F/dt = 1500\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	Q_r	0,70 2,50 3,00		μC μC μC
逆回復損失 Reverse recovery energy	$I_F = 15\text{ A}, -di_F/dt = 1500\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{rec}	0,40 0,85 1,10		mJ mJ mJ
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	/Diode (1 素子当り) / per diode		R_{thJC}	0,95	1,05	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/Diode (1 素子当り) / per diode $\lambda_{Paste} = 1\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ / $\lambda_{grease} = 1\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		R_{thCH}	0,85		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj\ op}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$

prepared by: CM	date of publication: 2014-07-21
approved by: MB	revision: 2.0



暫定データ
Preliminary Data

IGBT, アップコンバータ / IGBT, Boost
最大定格 / Maximum Rated Values

コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	650	V
コレクタ電流 Implemented collector current		I_{CN}	50	A
連続DCコレクタ電流 Continuous DC collector current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	$I_{C\text{nom}}$	40	A
繰り返しピークコレクタ電流 Repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ms}$	I_{CRM}	100	A
トータル損失 Total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	200	W
ゲート・エミッタ間ピーク電圧 Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.		
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 40\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $I_C = 40\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $I_C = 40\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{sat}}$	1,55 1,70 1,70	t.b.d.	V V V	
ゲート・エミッタ間しきい値電圧 Gate threshold voltage	$I_C = 0,80\text{mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$V_{G\text{Eth}}$	4,9	5,8	6,5	V
ゲート電荷量 Gate charge	$V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$		Q_G	0,50			μC
内蔵ゲート抵抗 Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$R_{G\text{int}}$	0,0			Ω
入力容量 Input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$		C_{ies}	2,95			nF
帰還容量 Reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$		C_{res}	0,096			nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流 Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 650\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{CES}			1,0	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流 Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}, V_{GE} = 20\text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{GES}			100	nA
ターンオン遅れ時間 (誘導負荷) Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 40\text{A}, V_{CE} = 350\text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $R_{Gon} = 6,8\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{on}}$	0,02 0,02 0,02			μs μs μs
ターンオン上昇時間 (誘導負荷) Rise time, inductive load	$I_C = 40\text{A}, V_{CE} = 350\text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $R_{Gon} = 6,8\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_r	0,01 0,013 0,013			μs μs μs
ターンオフ遅れ時間 (誘導負荷) Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 40\text{A}, V_{CE} = 350\text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $R_{Goff} = 6,8\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{off}}$	0,03 0,065 0,07			μs μs μs
ターンオフ下降時間 (誘導負荷) Fall time, inductive load	$I_C = 40\text{A}, V_{CE} = 350\text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $R_{Goff} = 6,8\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_f	0,012 0,013 0,014			μs μs μs
ターンオンスイッチング損失 Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 40\text{A}, V_{CE} = 350\text{V}, L_S = 25\text{nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}, di/dt = 3200\text{A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{Gon} = 6,8\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{on}	0,33 0,47 0,50			mJ mJ mJ
ターンオフスイッチング損失 Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 40\text{A}, V_{CE} = 350\text{V}, L_S = 25\text{nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}, du/dt = 5000\text{V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{Goff} = 6,8\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{off}	0,60 0,85 0,95			mJ mJ mJ
短絡電流 SC data	$V_{GE} \leq 15\text{V}, V_{CC} = 360\text{V}$ $V_{CE\text{max}} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$ $t_p \leq 5\mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		I_{SC}	180			A
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	IGBT部 (1素子当り) / per IGBT		$R_{th\text{JC}}$	0,60	0,75		K/W

prepared by: CM	date of publication: 2014-07-21
approved by: MB	revision: 2.0



暫定データ
Preliminary Data

ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	IGBT部 (1 素子当り) / per IGBT $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	R_{thCH}		0,85		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions		$T_{\text{vj op}}$	-40		150	°C

Diode-、チヨツパー / Diode-Chopper

最大定格 / Maximum Rated Values

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$	V_{RRM}		650		V
連続DC電流 Continuous DC forward current		I_{F}		15		A
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	$t_{\text{P}} = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}		30		A
電流二乗時間積 I^2t - value	$V_{\text{R}} = 0 \text{ V}, t_{\text{P}} = 10 \text{ ms}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $V_{\text{R}} = 0 \text{ V}, t_{\text{P}} = 10 \text{ ms}, T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	I^2t		22,5 20,5		A ² s A ² s

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	$I_{\text{F}} = 15 \text{ A}, V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$ $I_{\text{F}} = 15 \text{ A}, V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$ $I_{\text{F}} = 15 \text{ A}, V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	V_{F}	1,60 1,55 1,50	2,00	V V V
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	/Diode (1 素子当り) / per diode		R_{thJC}	2,25	2,50	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/Diode (1 素子当り) / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		R_{thCH}	1,40		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{\text{vj op}}$	-40	150	°C

prepared by: CM	date of publication: 2014-07-21
approved by: MB	revision: 2.0



暫定データ
Preliminary Data

Diode, アップコンバータ / Diode, Boost
最大定格 / Maximum Rated Values

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	650	V
連続DC電流 Continuous DC forward current		I_F	25	A
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	$t_P = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	50	A
電流二乗時間積 I^2t - value	$V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I^2t	50,0	A^2s

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	$I_F = 25\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 25\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 25\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	V_F	1,65 1,60 1,55	t.b.d.	V V V
ピーク逆回復電流 Peak reverse recovery current	$I_F = 25\text{ A}, -di_F/dt = 2500\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I_{RM}	38,0 43,0 45,0		A A A
逆回復電荷量 Recovered charge	$I_F = 25\text{ A}, -di_F/dt = 2500\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	Q_r	0,90 1,60 1,90		μC μC μC
逆回復損失 Reverse recovery energy	$I_F = 25\text{ A}, -di_F/dt = 2500\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{rec}	0,24 0,38 0,44		mJ mJ mJ
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	/Diode (1 素子当り) / per diode		R_{thJC}	1,95	2,15	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/Diode (1 素子当り) / per diode $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		R_{thCH}	1,35		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{ op}}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$

NTC-サーミスタ / NTC-Thermistor

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
定格抵抗値 Rated resistance	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$		R_{25}	5,00		$\text{k}\Omega$
R100の偏差 Deviation of R100	$T_C = 100^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493\ \Omega$		$\Delta R/R$	-5	5	%
損失 Power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$		P_{25}		20,0	mW
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		$B_{25/50}$	3375		K
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		$B_{25/80}$	3411		K
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		$B_{25/100}$	3433		K

適切なアプリケーションノートによる仕様
Specification according to the valid application note.

prepared by: CM	date of publication: 2014-07-21
approved by: MB	revision: 2.0



**暫定データ
Preliminary Data**

モジュール / Module

絶縁耐圧 Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V _{ISOL}	2,5		kV
内部絶縁 Internal isolation	基礎絶縁 (クラス1, IEC 61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)		Al ₂ O ₃		
沿面距離 Creepage distance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal		11,5 6,3		mm
空間距離 Clearance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal		10,0 5,0		mm
相対トラッキング指数 Comperative tracking index		CTI	> 200		
			min.	typ.	max.
内部インダクタンス Stray inductance module		L _{sCE}		25	nH
保存温度 Storage temperature		T _{stg}	-40		125 °C
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder mounting force per clamp		F	20	-	50 N
質量 Weight		G		24	g

Der Strom im Dauerbetrieb ist auf 25 A effektiv pro Anschlusspin begrenzt.
The current under continuous operation is limited to 25 A rms per connector pin.

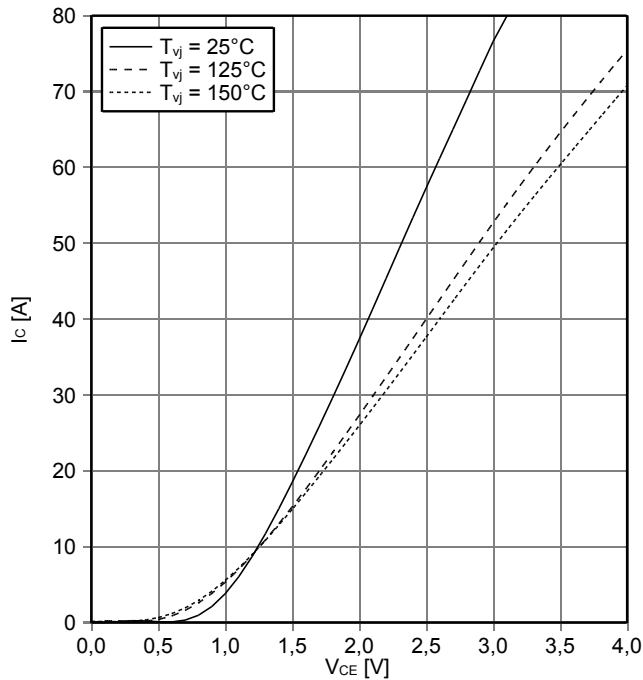
prepared by: CM	date of publication: 2014-07-21
approved by: MB	revision: 2.0



暫定データ
Preliminary Data

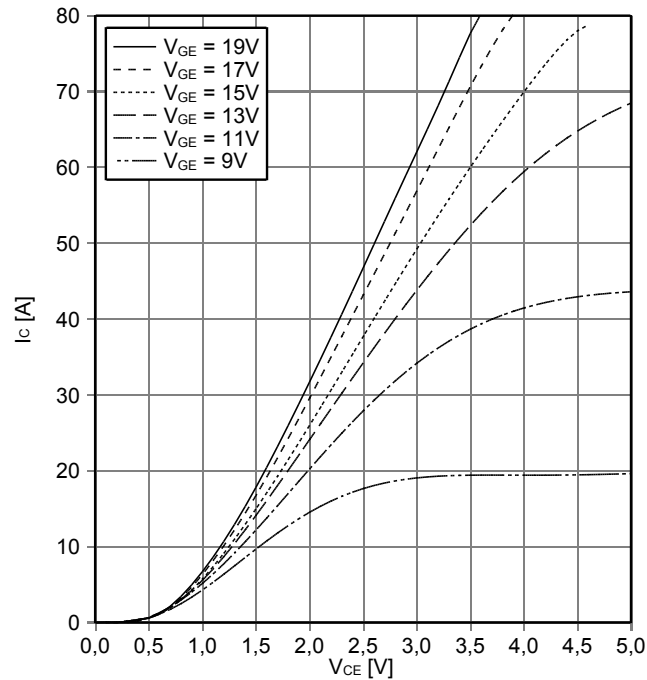
出力特性 IGBT, 降圧コンバータ (Typical)
output characteristic IGBT, Buck (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



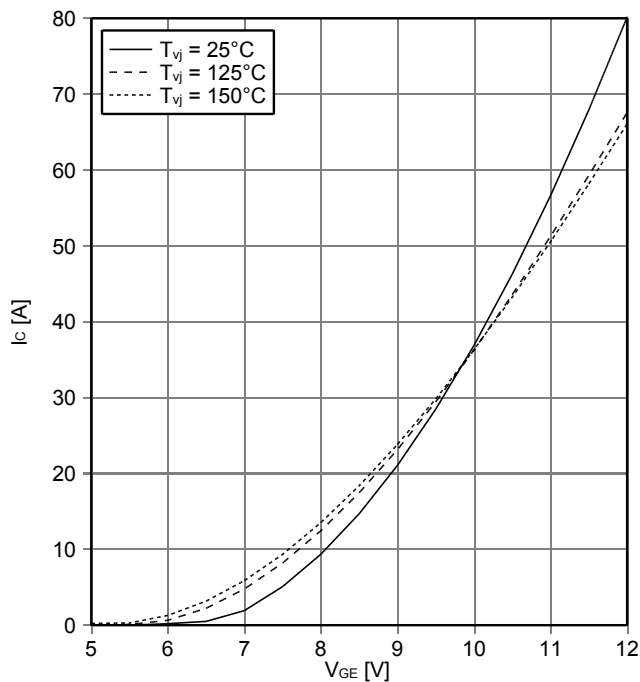
出力特性 IGBT, 降圧コンバータ (Typical)
output characteristic IGBT, Buck (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



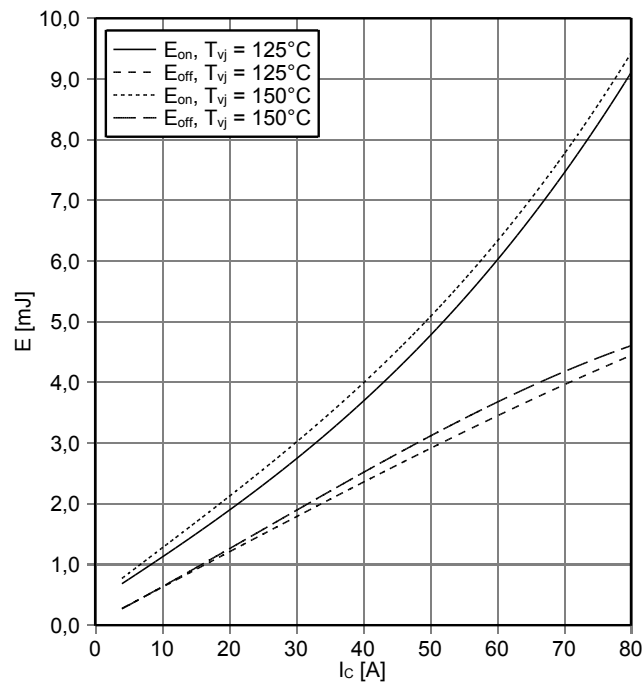
伝達特性 IGBT, 降圧コンバータ (Typical)
transfer characteristic IGBT, Buck (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



スイッチング損失 IGBT, 降圧コンバータ (Typical)
switching losses IGBT, Buck (typical)

$E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 12\ \Omega, R_{Goff} = 12\ \Omega, V_{CE} = 600\text{ V}$



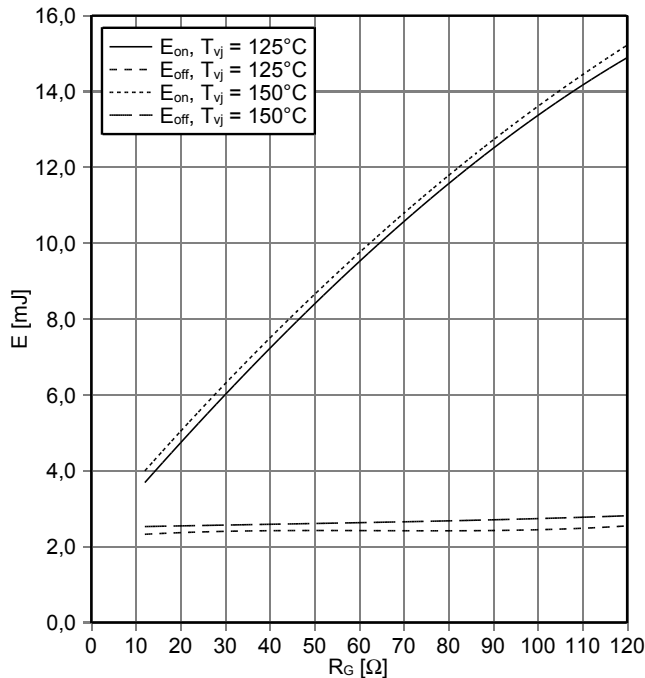
prepared by: CM	date of publication: 2014-07-21
approved by: MB	revision: 2.0



暫定データ
Preliminary Data

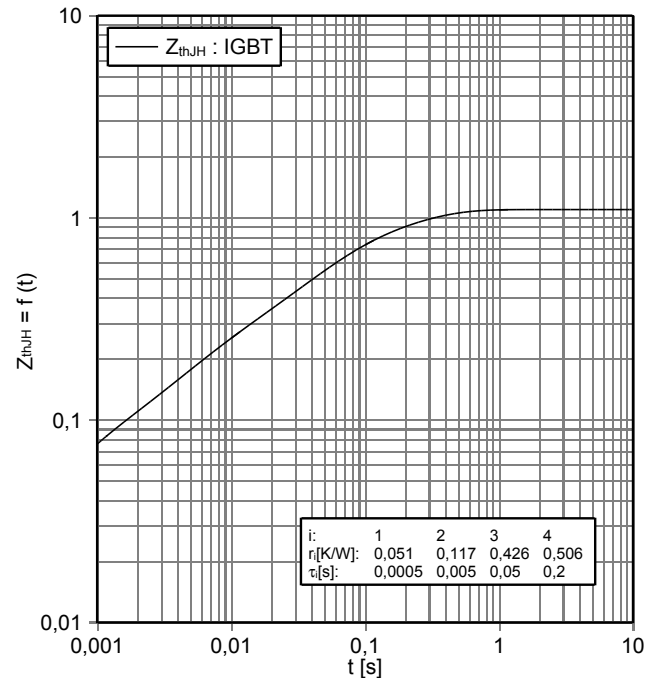
スイッチング損失 IGBT, 降圧コンバータ (Typical)
switching losses IGBT, Buck (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 40\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$



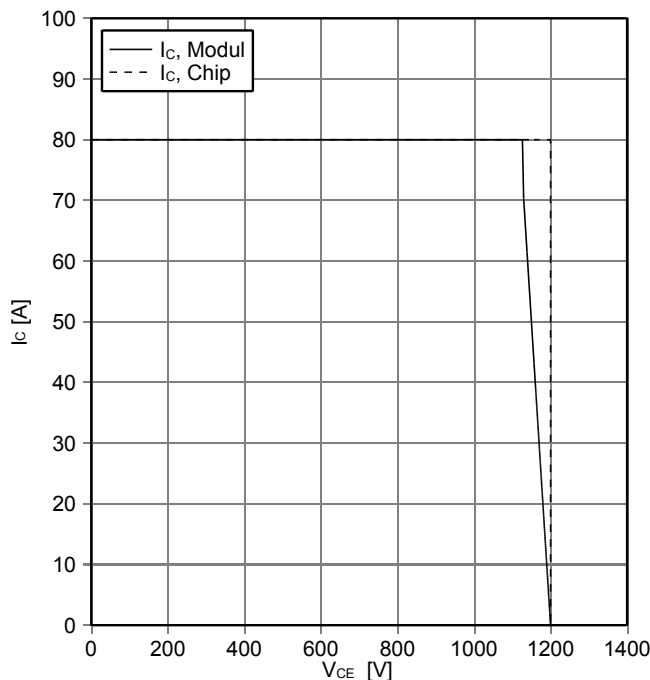
過渡熱インピーダンス IGBT, 降圧コンバータ
transient thermal impedance IGBT, Buck

$Z_{thJH} = f(t)$



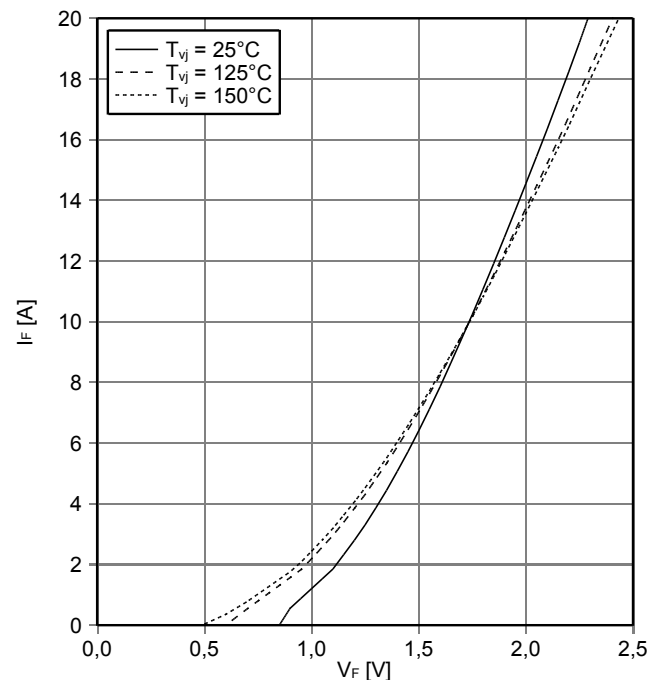
逆バイアス安全動作領域 IGBT, 降圧コンバータ (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT, Buck (RBSOA)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 12\ \Omega$, $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



順電圧特性 Diode、リバーズ (typical)
forward characteristic of Diode, Reverse (typical)

$I_F = f(V_F)$

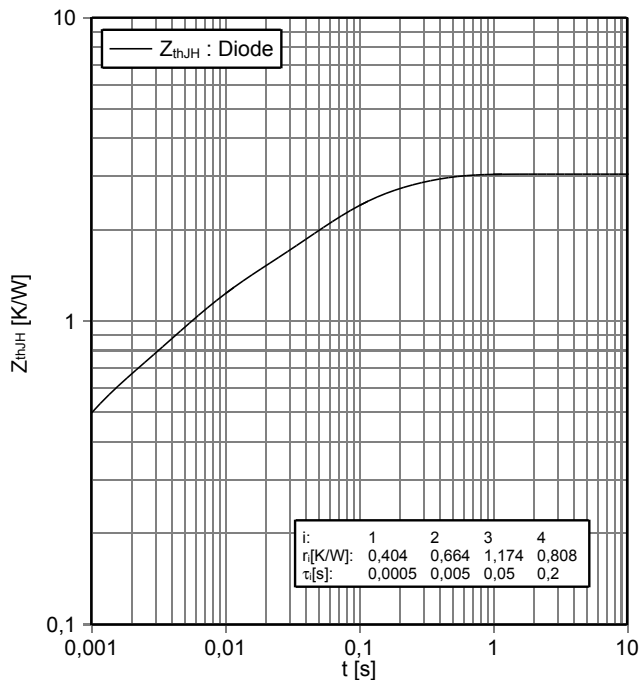


prepared by: CM	date of publication: 2014-07-21
approved by: MB	revision: 2.0

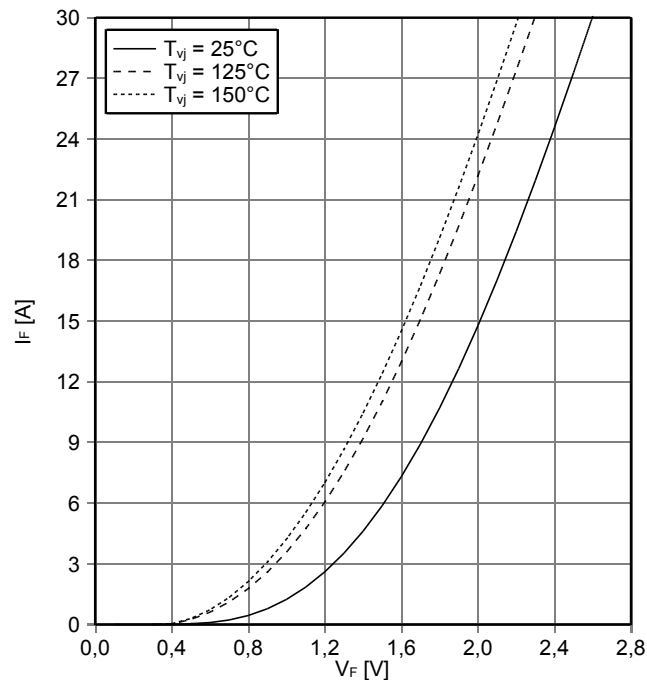


暫定データ
Preliminary Data

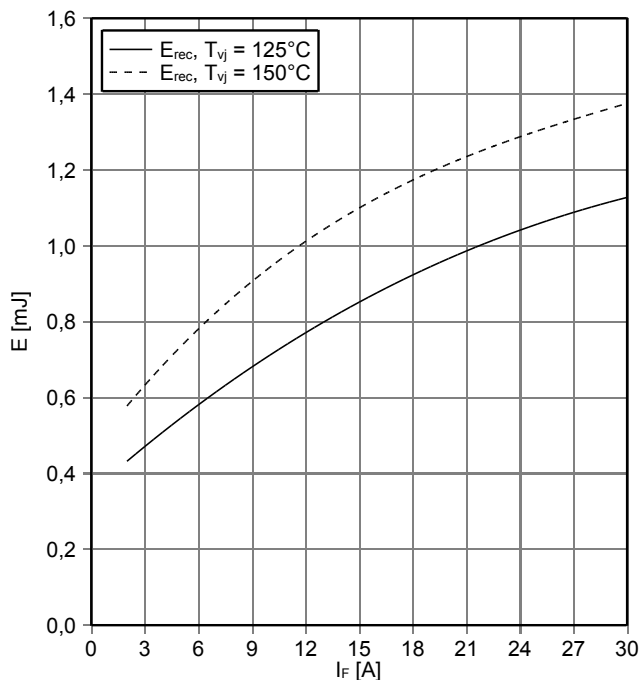
過渡熱インピーダンス Diode、リバース
transient thermal impedance Diode, Reverse
 $Z_{thJH} = f(t)$



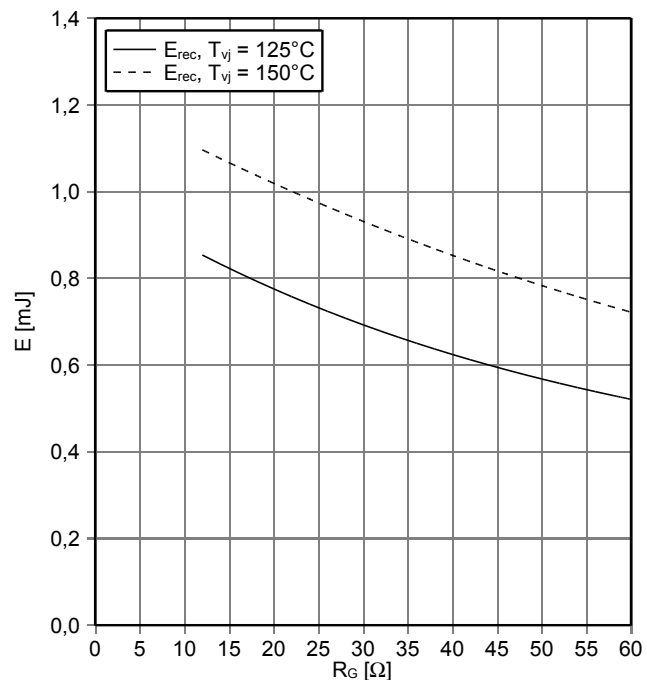
順電圧特性 Diode, 降圧コンバータ (typical)
forward characteristic of Diode, Buck (typical)
 $I_F = f(V_F)$



スイッチング損失 Diode, 降圧コンバータ (Typical)
switching losses Diode, Buck (typical)
 $E_{rec} = f(I_F)$
 $R_{Gon} = 12 \Omega, V_{CE} = 600 V$



スイッチング損失 Diode, 降圧コンバータ (Typical)
switching losses Diode, Buck (typical)
 $E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 15 A, V_{CE} = 600 V$



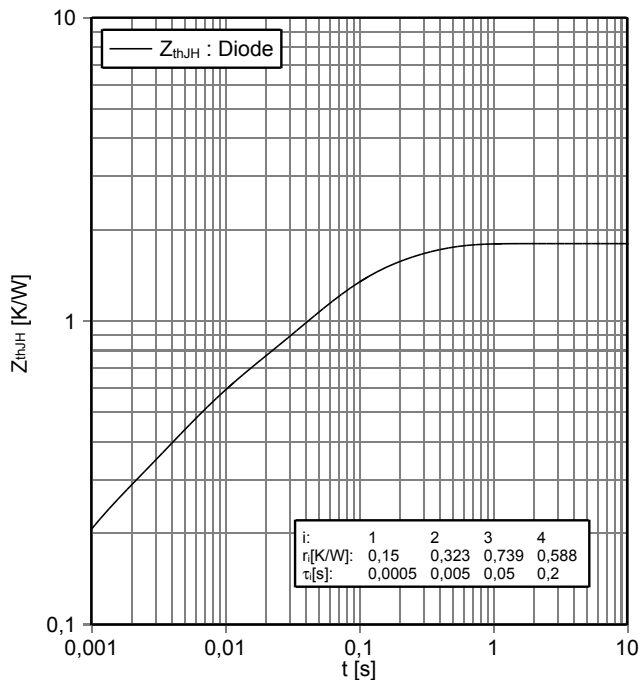
prepared by: CM	date of publication: 2014-07-21
approved by: MB	revision: 2.0



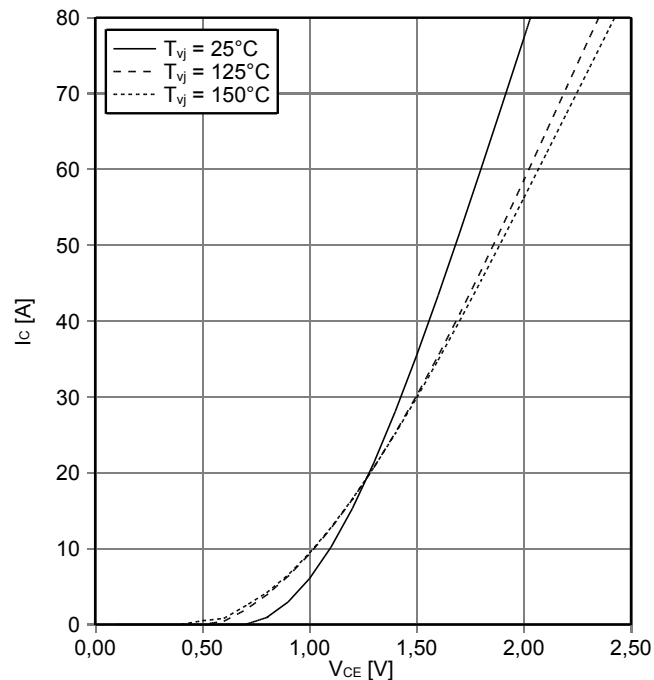
IGBT-モジュール
IGBT-Module **FD-DF80R12W1H3_B52**

暫定データ
Preliminary Data

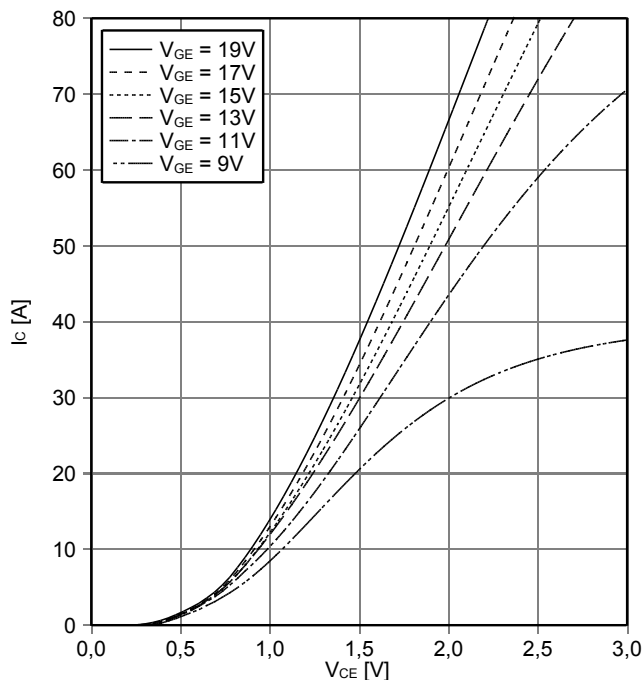
過渡熱インピーダンス Diode, 降圧コンバータ
transient thermal impedance Diode, Buck
 $Z_{thJH} = f(t)$



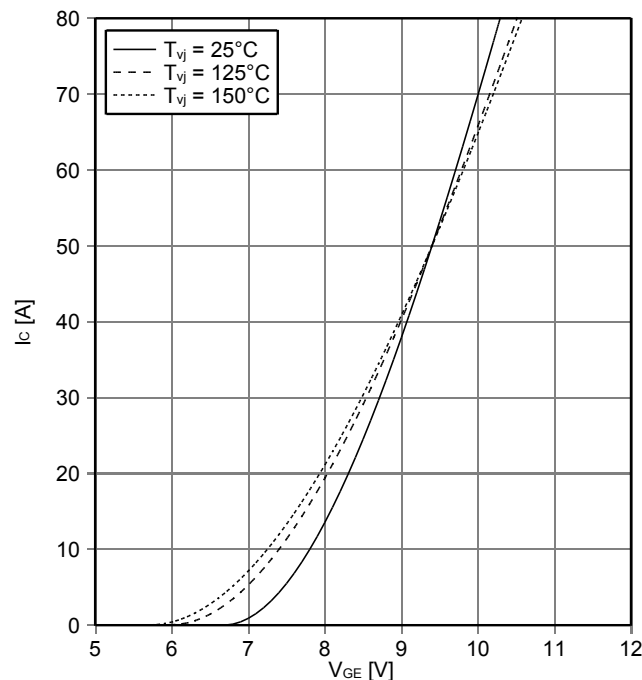
出力特性 IGBT, アップコンバータ (Typical)
output characteristic IGBT, Boost (typical)
 $I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



出力特性 IGBT, アップコンバータ (Typical)
output characteristic IGBT, Boost (typical)
 $I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



伝達特性 IGBT, アップコンバータ (Typical)
transfer characteristic IGBT, Boost (typical)
 $I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



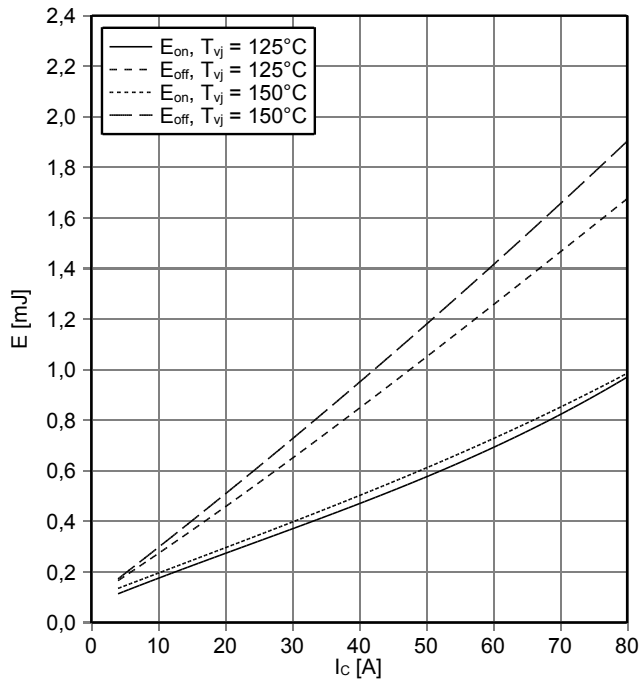
prepared by: CM	date of publication: 2014-07-21
approved by: MB	revision: 2.0



暫定データ
Preliminary Data

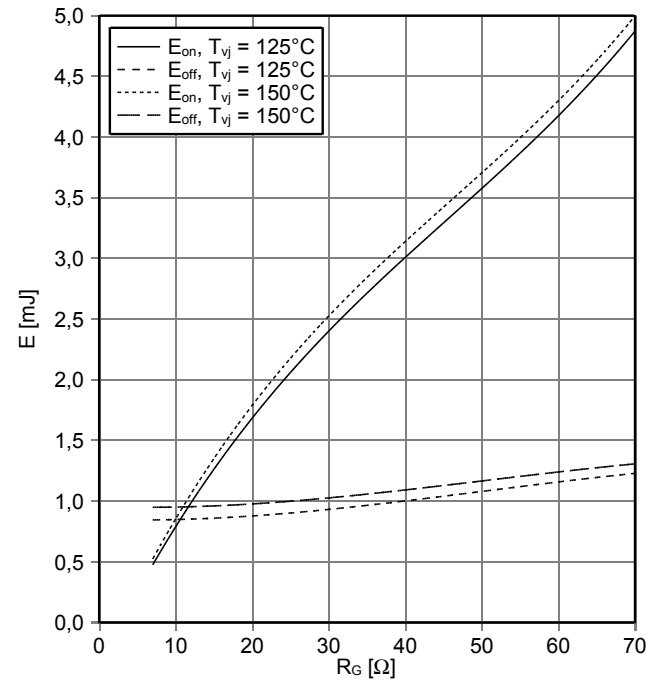
スイッチング損失 IGBT, アップコンバータ (Typical)
switching losses IGBT, Boost (typical)

$E_{on} = f(I_c)$, $E_{off} = f(I_c)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 6.8\ \Omega$, $R_{Goff} = 6.8\ \Omega$, $V_{CE} = 350\text{ V}$



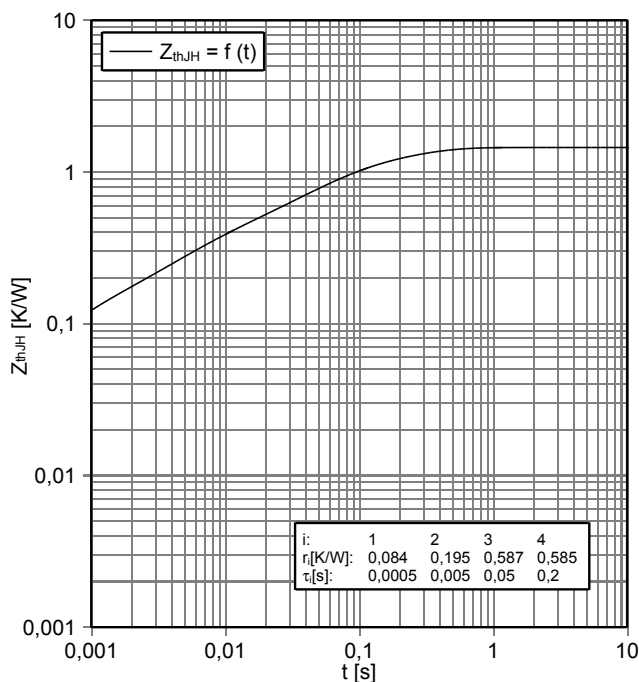
スイッチング損失 IGBT, アップコンバータ (Typical)
switching losses IGBT, Boost (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_c = 40\text{ A}$, $V_{CE} = 350\text{ V}$



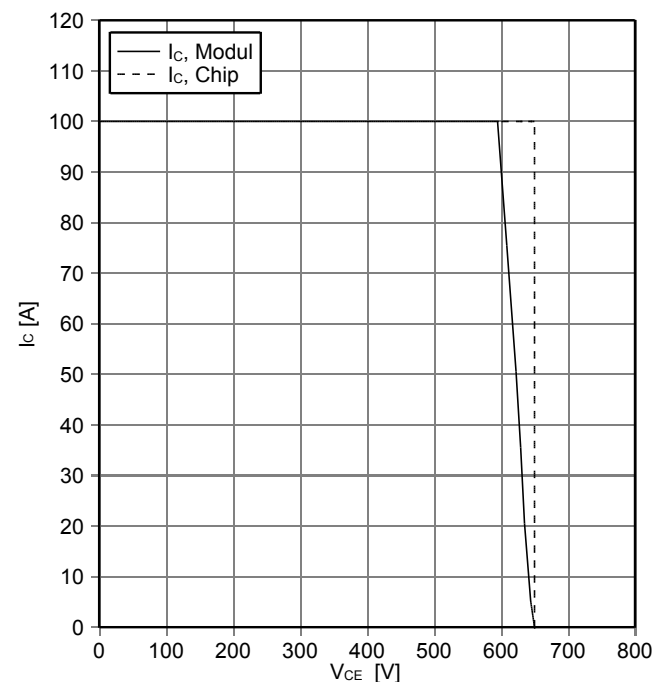
過渡熱インピーダンス IGBT, アップコンバータ
transient thermal impedance IGBT, Boost

$Z_{thJH} = f(t)$



逆バイアス安全動作領域 IGBT, アップコンバータ (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT, Boost (RBSOA)

$I_c = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 6.8\ \Omega$, $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$

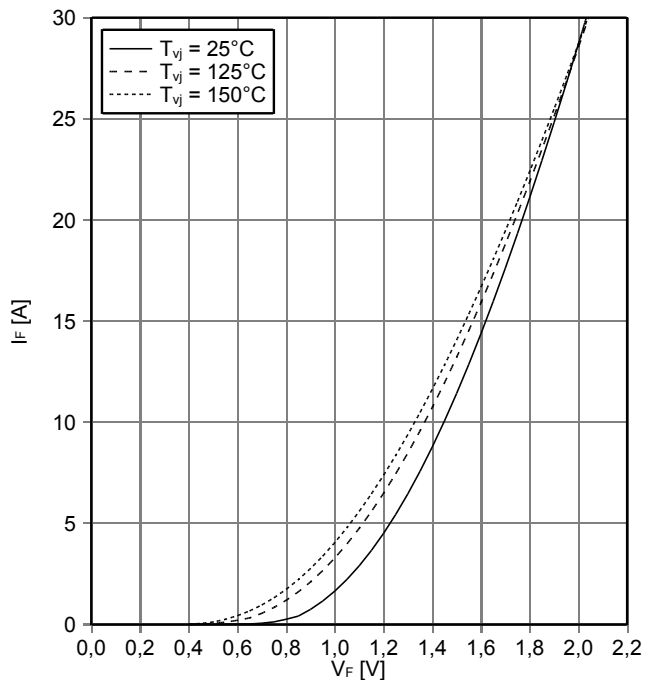


prepared by: CM	date of publication: 2014-07-21
approved by: MB	revision: 2.0

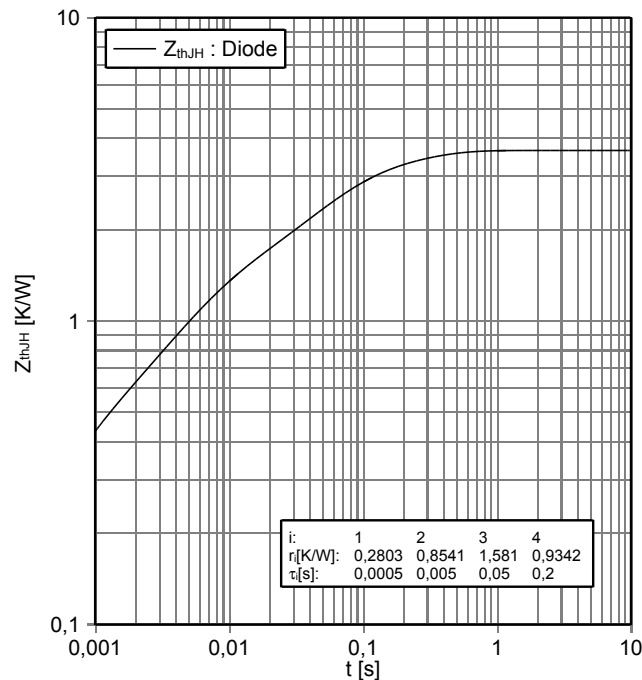


暫定データ
Preliminary Data

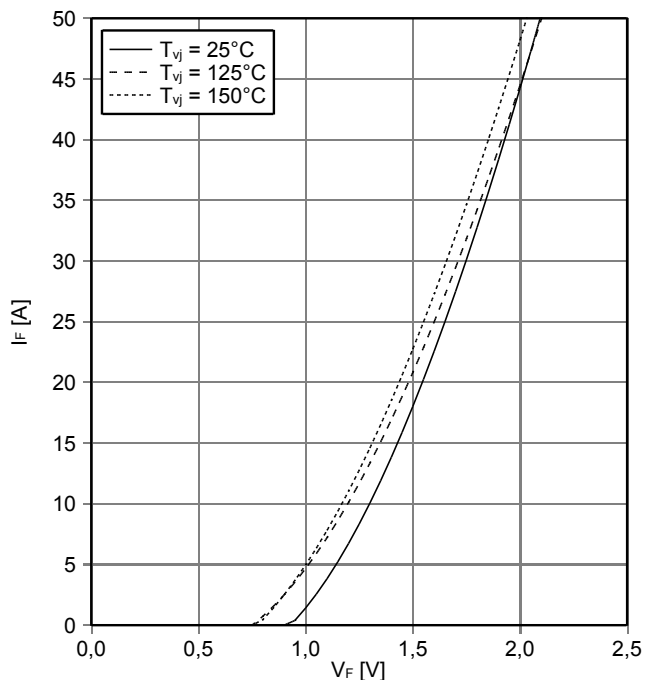
順電圧特性 Diode-、チョッパー (typical)
forward characteristic of Diode-Chopper (typical)
 $I_F = f(V_F)$



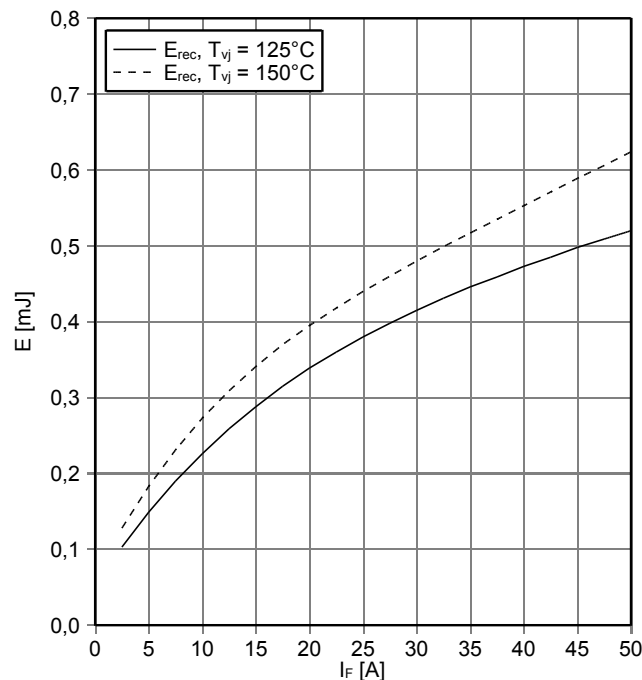
過渡熱インピーダンス Diode-、チョッパー
transient thermal impedance Diode-Chopper
 $Z_{thJH} = f(t)$



順電圧特性 Diode, アップコンバータ (typical)
forward characteristic of Diode, Boost (typical)
 $I_F = f(V_F)$



スイッチング損失 Diode, アップコンバータ (Typical)
switching losses Diode, Boost (typical)
 $E_{rec} = f(I_F)$
 $R_{Gon} = 6.8 \Omega, V_{CE} = 350 \text{ V}$



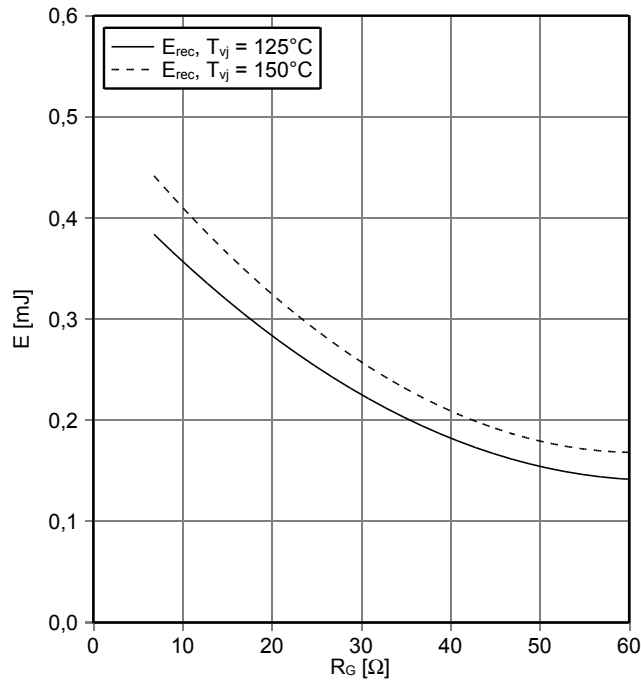
prepared by: CM	date of publication: 2014-07-21
approved by: MB	revision: 2.0



暫定データ
Preliminary Data

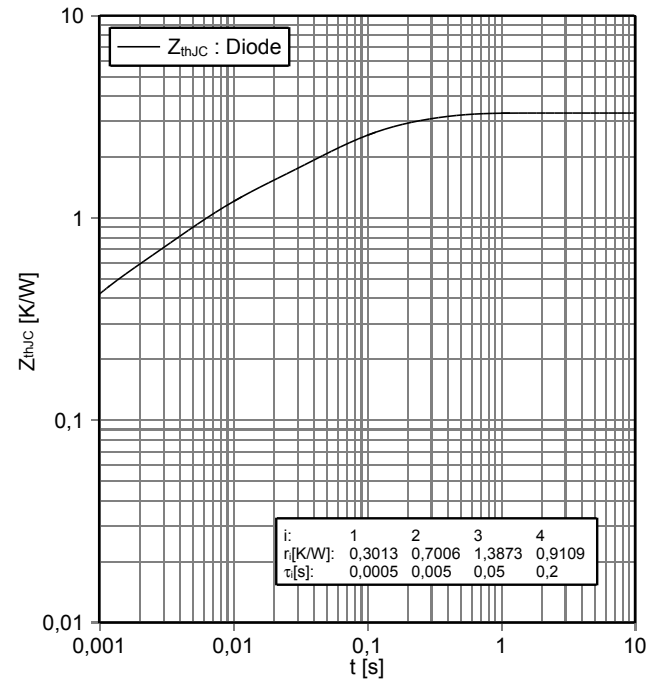
スイッチング損失 Diode, アップコンバータ (Typical)
switching losses Diode, Boost (typical)

$E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 25\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$

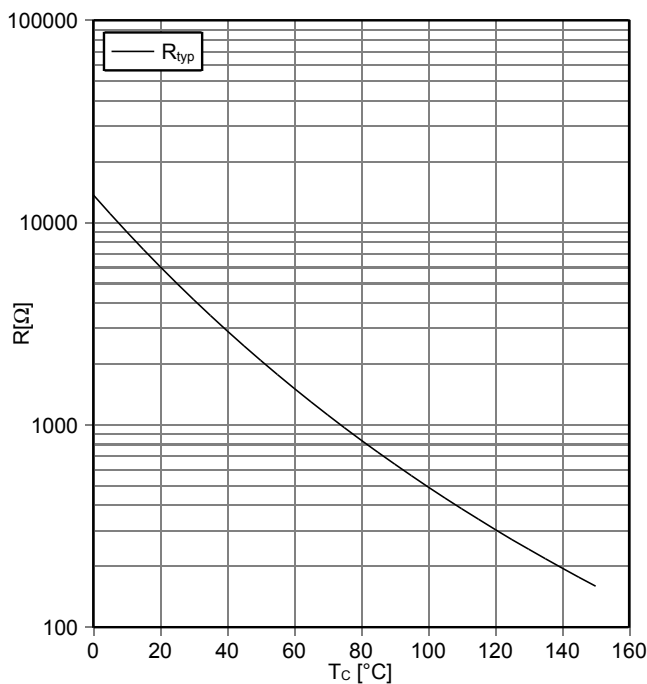


過渡熱インピーダンス Diode, アップコンバータ
transient thermal impedance Diode, Boost

$Z_{thJC} = f(t)$



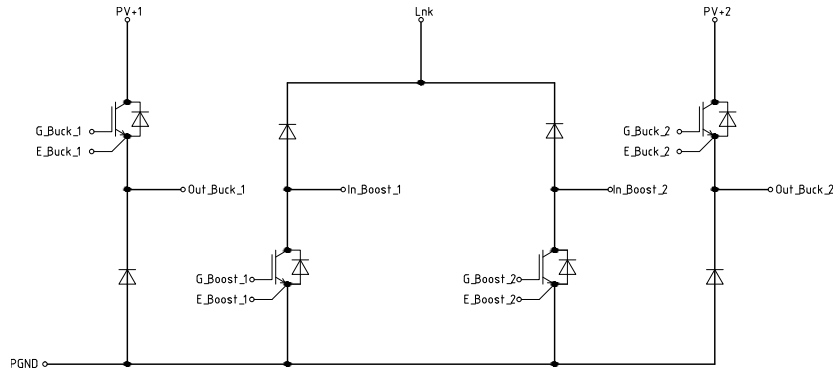
NTC-サーミスタ サーミスタの温度特性
NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)
 $R = f(T)$



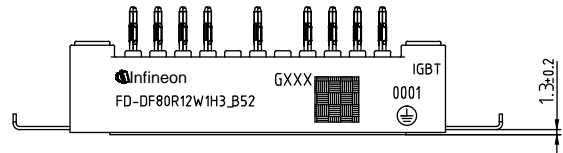
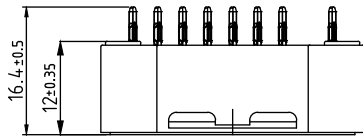
prepared by: CM	date of publication: 2014-07-21
approved by: MB	revision: 2.0

暫定データ
Preliminary Data

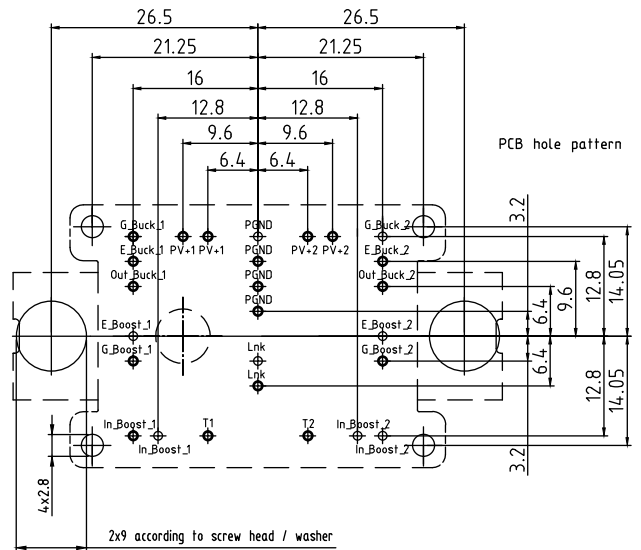
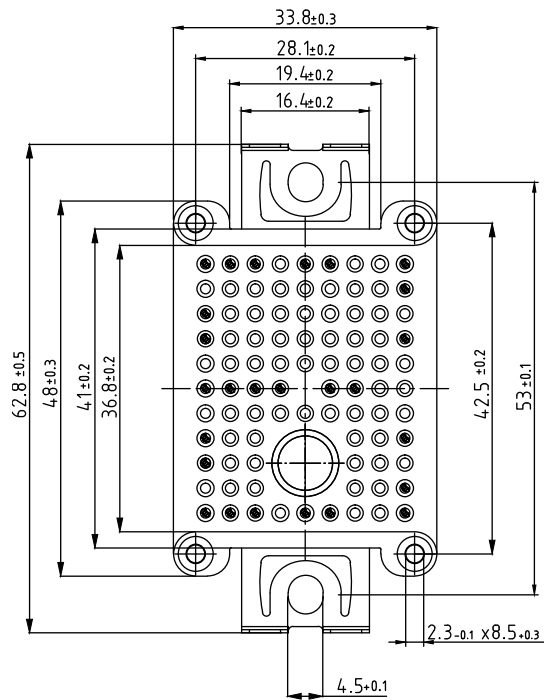
回路図 / circuit_diagram_headline



パッケージ概要 / package outlines



- Pin-Grid 3.2mm
- Tolerance of PCB hole pattern $\oplus \phi 0.1$
- Hole specification for contacts see AN 2009-01:
Diameters of drill ϕ 1.15mm
and copper thickness in hole 25-50 μ m



prepared by: CM	date of publication: 2014-07-21
approved by: MB	revision: 2.0



**暫定データ
Preliminary Data**

この日本語は、あくまで参考訳となりますので、正式はデータシートに記載されている英文の物となります。

この日本語は、あくまで参考訳となりますので、正式はデータシートに記載されている英文の物となります。

利用規約

このデータシートに記載されているデータ類は、技術者向けの物です。このデバイスを使用される際は、製品が使用されるアプリケーションにて、ご評価頂いた上で、アプリケーションに適切にご判断願います。

このデータシートには、保証されている特性が記述されております。

その他、保証内容は個々の契約期間や条件に応じて決定されます。

保証は、アプリケーションやその特性に対しては行いません。

実際のアプリケーションでの利用に関しては、必ず相当モジュールのアセンブリノートをご確認ください。

追加の技術的情報、アプリケーションでの使用方法について、ご質問がある際には、最寄のセールスオフィスにお問い合わせ願います。(www.infineon.com 参照)

製品にご興味頂き必要があれば、アプリケーションノートを準備させて頂くケースもあります。

技術的な要求によっては、当該製品が危険な物になり得る可能性があります。このようなことが起こる可能性がある場合は、製品を使用される方の責任にて、弊社セールスオフィスに連絡願います。

航空関連、もしくは医療機器や生命維持装置に使用される場合は、インフィニオンと下記の項目を合意しているか、ご確認願います。

- リスク 及び 品質の評価
- 品質契約
- アプリケーションの共同評価

上記の内容の状況に応じて、製品を出荷の判断をさせて頂く場合がございます。

必要に応じて、この規約を関係される方々に送付してください。

インフィニオンはこのデータシートを変更する権利を有します。

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics. The information in the valid application- and assembly notes of the module must be considered.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

prepared by: CM	date of publication: 2014-07-21
approved by: MB	revision: 2.0

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [IGBT Modules category](#):

Click to view products by [Infineon manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[F3L400R07ME4_B22](#) [F4-50R07W2H3_B51](#) [FB15R06W1E3](#) [FB20R06W1E3_B11](#) [FD1000R33HE3-K](#) [FD400R33KF2C-K](#)
[FD401R17KF6C_B2](#) [FD-DF80R12W1H3_B52](#) [FF200R06YE3](#) [FF300R12KE4_E](#) [FF450R12ME4P](#) [FF600R12IP4V](#) [FP10R06W1E3_B11](#)
[FP20R06W1E3](#) [FP50R12KT3](#) [FP75R07N2E4_B11](#) [FS10R12YE3](#) [FS150R07PE4](#) [FS150R12PT4](#) [FS50R07N2E4_B11](#) [FZ1000R33HE3](#)
[FZ1800R17KF4](#) [DD250S65K3](#) [DF1000R17IE4](#) [DF1000R17IE4D_B2](#) [DF1400R12IP4D](#) [DF200R12PT4_B6](#) [DF400R07PE4R_B6](#)
[BSM75GB120DN2_E3223c-Se](#) [F3L300R12ME4_B22](#) [F3L75R07W2E3_B11](#) [F4-50R12KS4_B11](#) [F475R07W1H3B11ABOMA1](#)
[FD1400R12IP4D](#) [FD200R12PT4_B6](#) [FD800R33KF2C-K](#) [FF1200R17KP4_B2](#) [FF300R17KE3_S4](#) [FF300R17ME4_B11](#) [FF401R17KF6C_B2](#)
[FF650R17IE4D_B2](#) [FF900R12IP4D](#) [FF900R12IP4DV](#) [STGIF7CH60TS-L](#) [FP50R07N2E4_B11](#) [FS100R07PE4](#) [FS150R07N3E4_B11](#)
[FS150R17N3E4](#) [FS150R17PE4](#) [FS225R12KE4](#)